

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-77593

(P2000-77593A)

(43)公開日 平成12年3月14日 (2000.3.14)

(51)Int.Cl.'

H 01 L 23/50  
C 25 D 5/12  
7/12

識別記号

F I

H 01 L 23/50  
C 25 D 5/12  
7/12

テロート(参考)

D 4 K 0 2 4  
5 F 0 6 7

7/12

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全6頁)

(21)出願番号

特願平10-241457

(22)出願日

平成10年8月27日 (1998.8.27)

(71)出願人 000005120

日立電線株式会社

東京都千代田区大手町一丁目6番1号

(72)発明者 秋野 久則

茨城県土浦市木田余町3550番地 日立電線  
株式会社システムマテリアル研究所内

(72)発明者 珍田 聰

茨城県土浦市木田余町3550番地 日立電線  
株式会社システムマテリアル研究所内

(74)代理人 100100240

弁理士 松本 幸

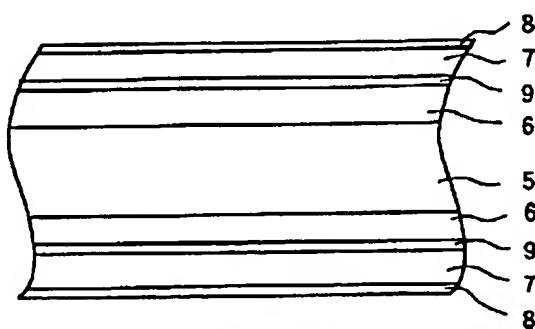
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 半導体用リードフレーム

(57)【要約】

【課題】半導体用リードフレームの加熱後のはんだ付け性、W/B性を優れたものにする。

【解決手段】銅合金から成るリードフレーム基材5上の全面にニッケルめっき膜6、パラジウムめっき膜7、金フランッシュめっき膜8を形成するリードフレームにおいて、ニッケルめっき膜6とパラジウムめっき膜7の中間にニッケル合金めっき膜9を形成し、4層構造めっきの半導体用リードフレーム1とする。



6 : Niめっき膜

7 : Pdめっき膜

8 : Auフランッシュめっき膜

9 : Ni合金めっき膜

PAT-NO JP02000077593A

DOCUMENT-IDENTIFIER JP 2000077593 A

TITLE LEAD FRAME FOR SEMICONDUCTOR

PUBN-DATE March 14, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
AKINO, HISANORI	N/A
CHINDA, SATOSHI	N/A
TOMOBE, MASAKATSU	N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
HITACHI CABLE LTD	N/A

APPL-NO JP10241457

APPL-DATE August 27, 1998

INT-CL (IPC): H01L023/50, C25D005/12, C25D007/12

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a lead frame for semiconductor which is superior in solderability after heating and W/B properties.

SOLUTION: A lead frame having a nickel plating film 6, a palladium plating

film 7 and a gold flash plating film 8 formed on the entire surface of a lead

frame basic material 5 of copper alloy is further provided with a nickel alloy

plating film between the nickel plating film 6 and the palladium plating film

7, thus obtaining a four-layer structure plated lead frame for semiconductor.

COPYRIGHT (C)2000,JPO